
	<h2>SIHP12N60E-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHP12N60E-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHP12N60E-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1200 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHP12N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1200 pcs Stock
Serie	E
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	147W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	937pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

SIHP12N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHP12N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP12N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP12N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHP12N60E-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP12N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP12N65E VB</b> SIHP12N65E VB</p>	 <p><b>SIHP12N65E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 12A TO-220AB</p>
 <p><b>SIHP12N60E</b> VISHAY SIHP12N60E VISHAY</p>	 <p><b>SIHP12N50E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP12N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP14N50D VB</b> SIHP14N50D VB</p>

### heiße Teile

Mehr

SIHFRC20TL-E3	SIHFS11N50A	SIHFS9N60A	SIHFSL11N50A	SIHG16N50C-E3
SIHG16N50C-E3	SIHG17N60D	SIHG20N50C	SIHG22N60S-E3	SIHG30N60E
SIHG33N60E	SIHG47N60E-E3	SIHG47N60E-E3	SIHG47N60E-GE3	SIHG47N60E-GE3
SIHG47N60S-E3	SIHG70N60EFEF-GE3	SIHG73N60E-GE3	SIHG73N60E-GE3	SIHP10N40D
SIHP12N50C-E3	SIHP12N50C-E3	SIHP12N60E-E3	SIHP12N60E-E3	SIHP12N60E-GE3
SIHP12N65E	SIHP14N50D	SIHP15N60E-E3	SIHP15N60E-E3	SIHP15N65E
SIHP16N50C-E3	SIHP16N50C-E3	SIHP17N60D-E3	SIHP17N60D-E3	SIHP18N50C-E3
SIHP18N50C-E3	SIHP22N60S-E3	SIHP30N60E-E3	SIHP30N60E-E3	SIHP30N60E-GE3
SIHP30N60E-GE3	SIHP30N60E-GE3	SIHP33N60E-GE3	SIHP33N60E-GE3	SIHP5N50D-E3
SIHP5N50D-E3	SIHP6N40D	SIHP8N50D-E3	SIHP8N50D-E3	SIHU3N50D-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited